

(492) ベーナイト変態に及ぼす Si の影響

(新熱延メタラジエ技術開発 - 4)

新日鐵・大分技研 ○ 脇田淳一 河野治
高橋学 江坂一彬

1. 緒言

前報¹⁾では、フェライトの恒温変態に及ぼす Si 量の影響を調べ、Si 量が 0.3%~0.5%で変態速度が減少し潜伏期も長くなり、変態点も下がるという特徴があることを報告した。

本報では引き続き、種々の温度でベーナイト恒温変態実験を行い、Si の影響を定量化したところ、興味ある知見が得られたので報告する。

2. 実験方法

Table 1 に供試材の成分を示す。C, Mn をほぼそろえて Si 量を 0.1%から 1.0%まで 4 水準に変えた。実験はフォーマスターを用いて Fig 1 のパターンで恒温変態を行った。また γ 粒径の影響を調べるために加熱温度を 3 水準に変えて実験を行った。

3. 実験結果

ベーナイト恒温変態は Johnson-Mehl 型の 1) 式で記述できた。

$$X = 1 - \exp \{-K \cdot (t - \tau)^n\}$$

$$K = \kappa / d \gamma^m \quad 1)$$

ここで τ は潜伏期、 $d \gamma$ は γ 粒径である。

τ は γ 粒径が大きくなると長くなり、Fig 2 に示すように Si 量が 0.5%付近で極大をとることがわかった。この挙動

はフェライトと同様であるが、¹⁾ 変化量の絶対値は小さくなっている。 τ は 2) 式と定式化できた。

$$\begin{aligned} \ln \tau &= 11.38 - 0.073 \cdot T + 6.92 \cdot 10^{-5} \cdot T^2 \\ &\quad + 11.47 \cdot (\%C) + 1.119 \cdot (\%Mn) \\ &\quad + 1.58 \cdot (\%Si) - 1.06 \cdot (\%Si)^2 \\ &\quad + 0.62 \cdot \ln(d \gamma) \quad 2) \end{aligned}$$

K は γ 粒径が大きくなると小さくなる。また Fig 3 に示すように Si 量に関しては単調減少であるが、0.5%を超えると急激に減少する。K は 3) 式と定式化できた。

$$\begin{aligned} \ln K &= -18.46 + 0.087 \cdot T - 7.98 \cdot 10^{-5} \cdot T^2 - 11.47 \cdot (\%C) \\ &\quad - 1.119 \cdot (\%Mn) - 1.64 \cdot (\%Si)^2 - 0.4 \cdot \ln(d \gamma) \quad 3) \end{aligned}$$

1) 式、2) 式の γ 粒径の指數についてはほぼ同一の値を得た。ただし Si less 材の場合の、 τ については 0.8、K については 1.76 という結果とかなり異なっていることがわかった。

また n については、ほぼ 1.4 で一定であった。

4. 結言

① 潜伏期は Si が 0.5% 付近で極大をとる。この傾向はフェライト変態と同様である。

② 変態速度は Si 量に関して単調減少であり、0.5%を超えると急激に減少する。

(参考文献)

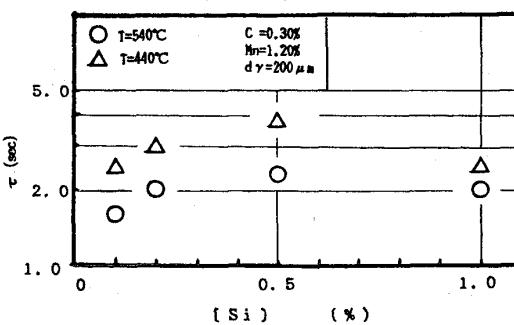
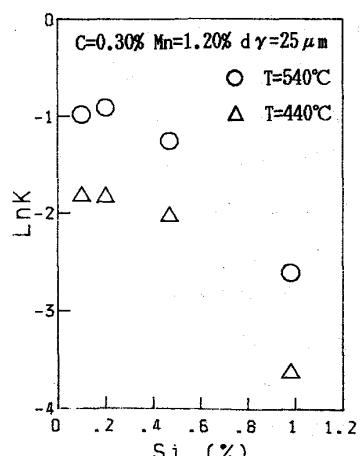
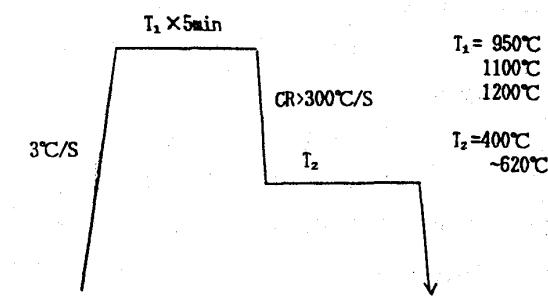
Fig 2. Effect of silicon content on τ Fig 3. Effect of silicon content on $\ln K$ 

Fig 1. Schematic illustration of experimental conditions

1) 脇田淳一、河野治、高橋学、江坂一彬：鉄と鋼 1986, 72, 13, S597